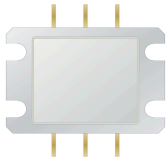
2300–3900 MHz GaN 内部整合型パワートランジスタ — PSAT 50 dBm (標準値)

LCT-2300-3900-PS50T · 2300–3900 MHz · GaN 内部整合型パワートランジスタ.



RF 電気特性表の規定値: PSAT 50 dBm (標準値); 電力利得 12 dB (標準値); PAE 50 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS.

GF136GD

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

RF ポートに外付け DC ブロック・コンデンサが必要です。

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

パッケージ外形寸法: 24 × 15.9 × 4.4 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	2300	-	3900	MHz
飽和出力電力	-	49	50	-	dBm
電力利得	-	11	12	-	dB
電力付加効率	-	45	50	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	1.5	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
ピンチオフ電圧 [1]	-	-4	-	-2	V
ゲート逆方向電流 [2]	-	-	-	0.01	A

[1] VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA
[2] VDS = 0 V; VGS = -10 V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	50	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	175	°C
最大チャネル温度	-	-	-	200	°C

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	24 × 15.9 × 4.4	mm
端子全幅	17.4	mm

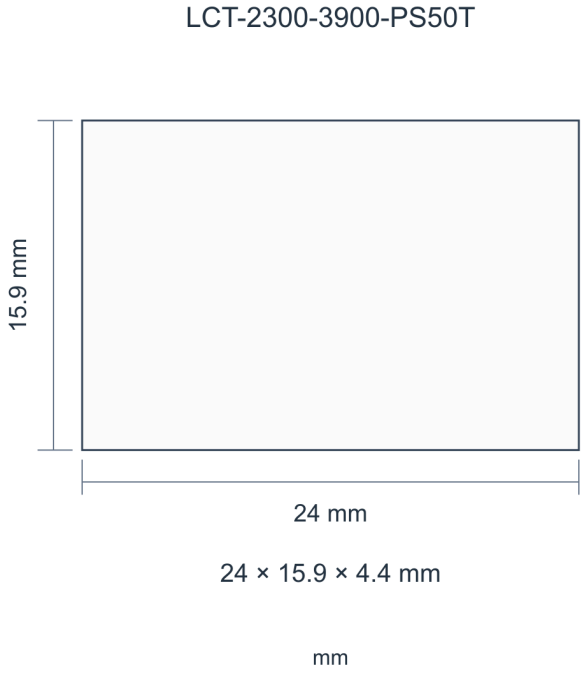
現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

実装上の注意

GF136GD ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF RF ポートに外付け DC ブロック・コンデンサが必要です。 Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。

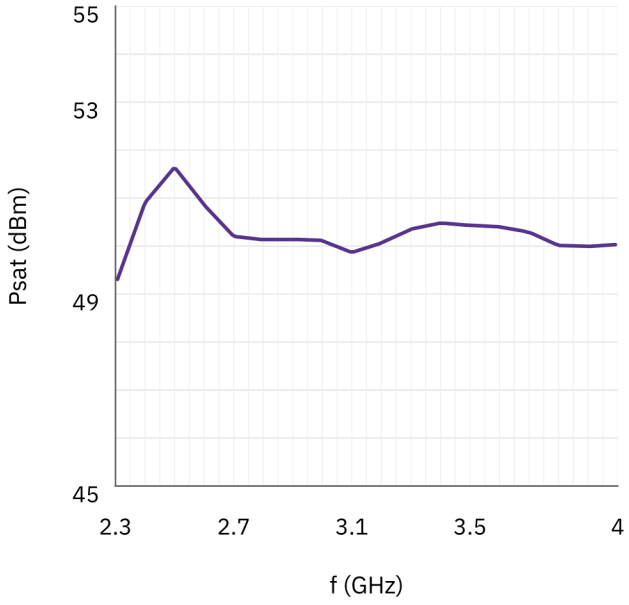


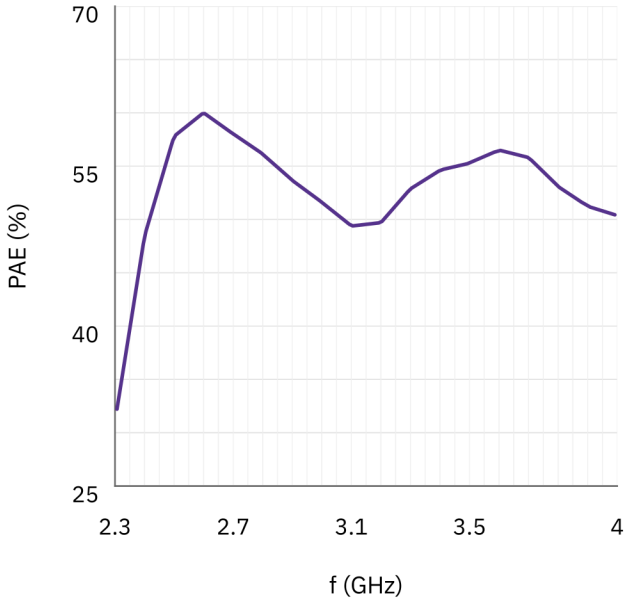
性能特性曲線

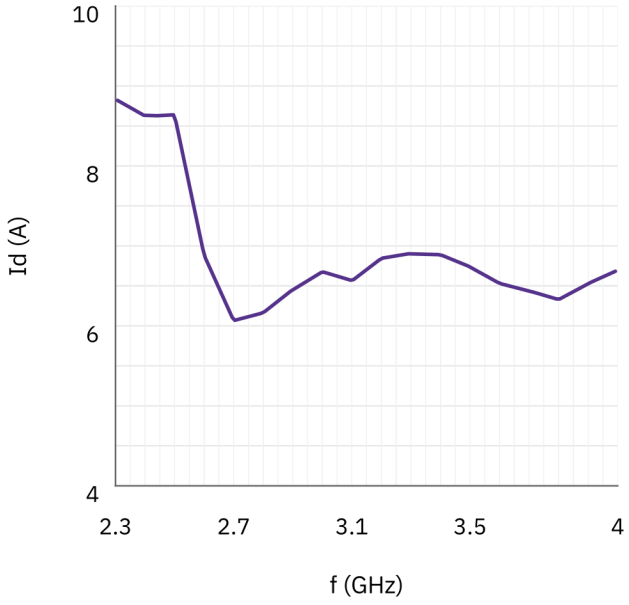
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

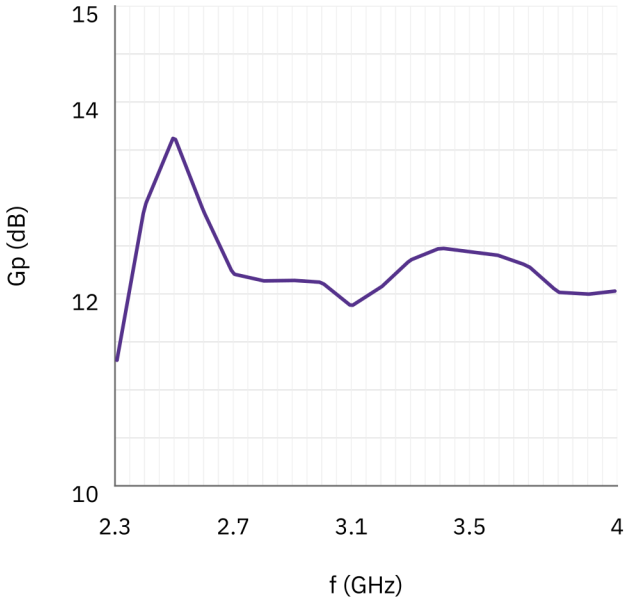
連続波（CW） – 飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、電力利得。

図の注記：Vd=+28V; Vg=-3.3V; Pin=38dBm。 読み取り値は近似値です。









文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。